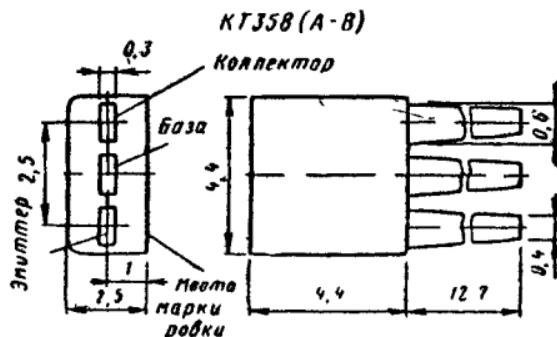


КТ358А, КТ358Б, КТ358В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *п-п-п* усиленные. Предназначены для применения в усилителях и генераторах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 0,2 г



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{KB} = 5,5$ В, $I_B = 20$ мА

КТ358А

10 100

КТ358Б

25 100

КТ358В

50 200

Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{KB} = 10$ В, $I_B = 5$ мА, не менее

КТ358А

80 МГц

КТ358Б, КТ358В

120 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, не более

500 пс

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K = 20$ мА, $I_B = 2$ мА, не более

0,8 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K = 20$ мА, $I_B = 2$ мА, не более

11 В

Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 15$ В для КТ358А

10 мкА

КТ358В и $U_{KB} = 30$ В для КТ358Б, не более

10 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{BB} = 4$ В, не более

10 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:

45 В

КТ358А, КТ358В

30 В

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{es} \leq 100$ Ом:

15 В

КТ358А, КТ358В

30 В

КТ358Б

4 В

Постоянное напряжение эмиттер — база

30 мА

КТ358А, КТ358В

60 мА

КТ358Б

Импульсный ток коллектора

100 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $t_u \leq 1$ мкс

200 мВт

Постоянное сопротивление переход — среда

0,7°C/Вт

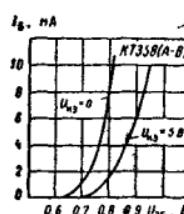
Температура *p-n* перехода

+120 °C

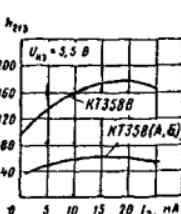
Температура окружающей среды

-40 +85 °C

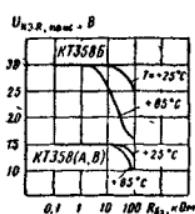
Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 см от корпуса, время пайки не более 10 с, температура пайки не должна превышать +250 °C



Входные характеристики



Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимости максимального напряжения коллектор — эмиттер от температуры